

**СПИСОК**  
**опубликованных научных и учебно-методических работ**

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук

№ п/ п	Наименование работы	Вид работы	Выходные данные	Соавторы
1	2	3	4	5
1	Real-time ellipsometric study of Ge+ ion implanted SiO <sub>2</sub> layers during fast annealing	статья	Phys. Stat. Sol. (c) v.5, N5, (2008) p.1287-1289	V.A.Shvets, I.E.Tyschenko, S.I.Chikichev, V.Yu.Prokopiev
2	Spectroscopic ellipsometry characterization of the optical properties and thermal stability of ZrO <sub>2</sub> films made by ion-beam assisted deposition	статья	Applied Physics Letters, 2008, V.92, 011917.	C. V. Ramana, S. Utsunomiya, R. C. Ewing, U. Becker, V. V. Atuchin, V. Sh. Aliev, V. N. Kruchinin
3	Эллипсометрическая порометрия тонкопленочных систем на основе кремния	статья	Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования №9 2003, с. 17-23	И.А. Леонов, К.П. Могильников О.П. Пчеляков
4	Измерение нормированной матрицы Джонса анизотропных образцов методом статической эллипсометрии	статья	Оптика и Спектроскопия, 2008, том 105,н.4, с.689-695	В.А.Швец, Е.В.Спесивцев, С.В.Рыхлицкий
5	Эллипсометрия физико-химических процессов на межфазных границах.	статья	Конденсированные среды и межфазные границы. 2006, т.8, №4, с.327	С.В.Рыхлицкий, В.А.Швец, Е.В.Спесивцев, Н.Н.Михайлов
6	Исследование процесса роста пленки Ge на поверхности Si(100) методом регистрирующей дифрактометрии	статья	Физика и техника полупроводников. т.35 вып.9 (2001) с.1032-1035	А.И.Никифоров, В.А.Черепанов, О.П.Пчеляков
7	Оптические свойства монослоев германия на кремнии	статья	Физика и техника полупроводников, в. 35, № 8 2001, p.979	Т.М.Бурбаев, Т.Н. Заварицкая, В.А.Курбатов, Н.Н.Мельник, В.А.Цветков, К.С. Журавлев, В.А.Марков, А.И.Никифоров

8	In situ RHEED control of self-organized Ge quantum dots	статья	Thin Solid Films v.380 No.1-2 (2001) 158-163	A.I. Nikiforov, V.A. Cherepanov, O.P. Pchelyakov, A.V. Dvurechenskii A.I. Yakimov
9	Oscillation of in-plane lattices constant of Ge islands during molecular beam epitaxy growth on Si	статья	Materials Science and Engineering B89 (2002) 180-183	A.I. Nikiforov, V.A. Cherepanov, O.P. Pchelyakov

Ученый секретарь ИФП СО РАН



Чтобы распечатать

А.В. Каламейцев

Подпись с расшифровкой